

Procedeu de obținere a structurilor semiconductoare poroase care constă în aceea că pe suprafața semiconductorului se depune o mască, pe regiunile neacoperite se implantează ioni de energie înaltă, apoi masca se înlătură, iar suprafața semiconductorului se corodează electrochimic, caracterizat prin aceea că înainte de corodare pe suprafața semiconductorului repetat se depune o mască numai pe regiunile care au fost implantate cu ioni, iar pe regiunile neacoperite se implantează ioni de energie înaltă diferită de cea anterioară și se înlătură masca.